



桂林斯壯微電子有限責任公司

Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

BAS19

SWITCHING DIODE 開關二極管

■FEATURES 特點

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Power dissipation 耗散功率	$P_D(T_a=25^\circ\text{C})$	225	mW
Forward Current 正向電流	I_F	200	mA
Reverse Voltage 反向電壓	V_R	120	V
Junction and Storage Temperature 結溫和儲藏溫度	T_J, T_{stg}	-55to+150°C	

■DEVICE MARKING 打標

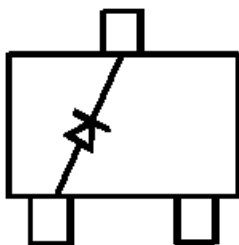
BAS19=JP

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊说明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 ($I_R=100\mu\text{A}$)	$V_{(BR)}$	120	—	V
Reverse Leakage Current 反向漏電流 ($V_R=100\text{V}$)	I_R	—	100	nA
Forward Voltage(Test Condition)正向電壓 $I_F=100\text{mA}$ $I_F=200\text{mA}$	V_F	—	1000 1250	mV
Diode Capacitance 二極體電容 ($V_R=0\text{V}$, $f=1\text{MHz}$)	C_D	—	5	pF
Reverse Recovery Time 反向恢復時間	T_{rr}	—	50	nS

■SOT-23 内部结构

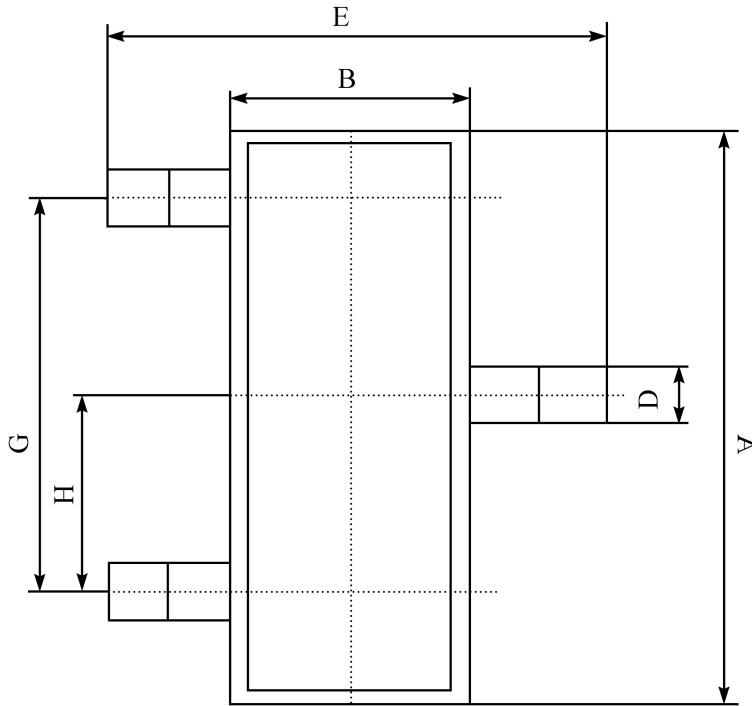




BAS19

■ **DIMENSION** 外形封裝尺寸

單位(UNIT): mm



序號	數值及公差
A	2.90±0.10
B	1.30±0.10
C	1.00±0.10
D	0.40±0.10
E	2.40±0.20
G	1.90±0.10
H	0.95±0.05
J	0.13±0.05
K	0.00-0.10
M	≥0.2
N	0.60±0.10
P	7±2°

